

## КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

05;08

© 1994 г.

Журнал технической физики, т. 64, в. 12, 1994

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ  
ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛА  
НА КРИТИЧЕСКУЮ ПЛОТНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫХ  
БЛОХОВСКИХ ЛИНИЙ В ДОМЕННЫХ ГРАНИЦАХ**

*А.И.Линник, А.М.Прудников*

Донецкий физико-технический институт АН Украины,  
340114, Донецк, Украина

(Поступило в Редакцию 28 декабря 1993 г.)

Стремление к повышению плотности записи информации в устройствах на основе магнитных носителей привело к использованию объектов, более мелких, чем цилиндрические магнитные домены (ЦМД), — пар вертикальных блоховских линий (ВБЛ), локализованных внутри доменной границы (ДГ) в пленках ферритов-гранатов [1,2]. Однако вопрос о влиянии основных параметров таких пленок на предельную плотность ВБЛ изучен сравнительно слабо [3,4]. В связи с этим в данной работе исследован ряд пленок толщиной 5–10 мкм, состав и параметры которых приведены в дальнейшем в таблице. Методика проведения эксперимента аналогична той, которая применена в работе [4].

Критическую плотность  $\eta$  ВБЛ в доменной границе ЦМД определяли как отношение числа  $n$  ВБЛ к периметру  $\pi d$  ЦМД в момент коллапса  $\eta = n / (\pi d)$ .

Термин “критическая плотность” в данном случае предполагает, что коллапс ЦМД, содержащего в своей ДГ большое количество ВБЛ, происходит в результате потери устойчивости вертикальных блоховских линий и их спонтанной аннигиляции [4,5].

Результаты исследований приведены в таблице и разбиты на группы таким образом, чтобы в каждой группе при постоянстве прочих параметров варьировался один из существенных параметров материала: константа  $A$  неоднородного обменного взаимодействия (образцы 1–3); намагниченность насыщения  $4\pi M_s$  (образцы 4–8), поле одноосной анизотропии  $H_A$  (образцы 9–11).

Кроме того, для ряда образцов была исследована зависимость критической плотности ВБЛ от температуры (рис. 1), при этом имелось в виду, что параметры материала являются функцией температуры.

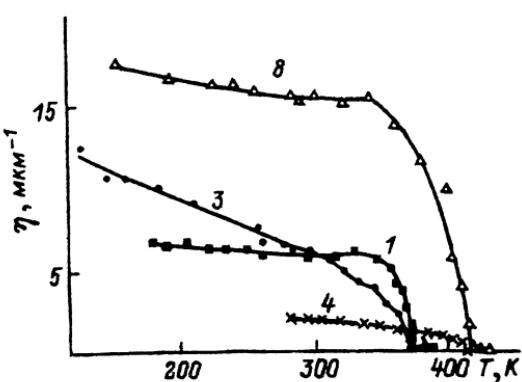


Рис. 1. Зависимость критической плотности ВБЛ от температуры.

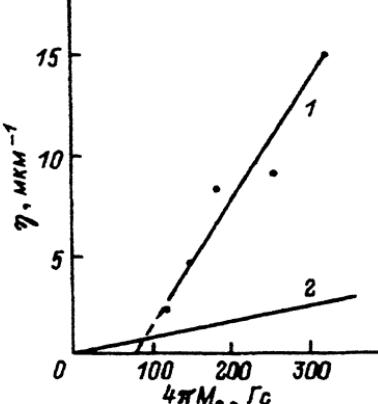


Рис. 2. Зависимость экспериментальной (1) и теоретической (2) плотности ВБЛ от намагниченности насыщения.

Как видно из рис. 1, зависимость  $\eta = \eta(T)$  носит резко нелинейный характер, а критическая плотность ВБЛ падает до нуля при определенной для каждого образца температуре, которая, однако, как оказалось, всегда ниже соответствующей температуры Нееля на 15–30°.

В то же время анализ результатов, приведенных в таблице, показывает, что, слабо увеличиваясь с увеличением константы обмена (образцы 1–3), критическая плотность ВБЛ сильно увеличивается с ростом  $4\pi M_s$ , (образцы 4–8) и практически не зависит от анизотропии материала (образцы 9–11).

В соответствии с теорией [5] ширина изолированной ВБЛ по порядку величины определяется параметром  $\Lambda_0 = [A / (2\pi M_s^2)]^{1/2}$ . Отсюда плотность ВБЛ, пропорциональная  $\Lambda_0^{-1}$ , должна иметь следующую зависимость от параметров материала

$$\eta \sim \Lambda_0^{-1} = (2\pi M_s^2 / A)^{1/2}. \quad (1)$$

Номер образца	Состав	$4\pi M_s, \text{Гс}$	$H_A, \text{Э}$	$A \cdot 10^7, \text{Э/см}$	$\eta, \mu\text{мм}^{-1}$
1	(YSm) <sub>3</sub> (FeGa) <sub>5</sub> O <sub>12</sub>	203	1550	1.68	6.5
2	(BiTm) <sub>3</sub> (FeGa) <sub>5</sub> O <sub>12</sub>	190	1291	1.88	5.1
3	(YSmLuCa) <sub>3</sub> (FeGe) <sub>5</sub> O <sub>12</sub>	181	1550	2.71	8.3
4	(BiEuGd) <sub>3</sub> (FeGa) <sub>5</sub> O <sub>12</sub>	118	1680	2.85	2.3
5	(YSmLuCa) <sub>3</sub> (FeGe) <sub>5</sub> O <sub>12</sub>	146	1420	2.63	4.5
6	(YSmLuCa) <sub>3</sub> (FeGe) <sub>5</sub> O <sub>12</sub>	181	1550	2.71	8.3
7	(YSmLuCa) <sub>3</sub> (FeGe) <sub>5</sub> O <sub>12</sub>	253	1340	2.69	9.1
8	(YSmCa) <sub>3</sub> (FeGe) <sub>5</sub> O <sub>12</sub>	319	1640	2.88	15.1
9	(YEu) <sub>3</sub> (FeGa) <sub>5</sub> O <sub>12</sub>	98	890	1.54	5.8
10	(YBi) <sub>3</sub> (FeGa) <sub>5</sub> O <sub>12</sub>	104	3400	1.64	4.9
11	(YBi) <sub>3</sub> (FeGa) <sub>5</sub> O <sub>12</sub>	85	6100	1.53	4.6

Экспериментально наблюдаемые величины  $\eta$  в общем подтверждают зависимость (1), хотя связь с обменной константой не так однозначна.

Очевидно также, что уменьшение критической плотности ВБЛ с ростом температуры (рис. 1) объясняется тем, что с приближением температуры к точке Нееля резко уменьшается намагниченность насыщения материала. Это тем более очевидно, поскольку анализ данных таблицы показывает, что возможные температурные изменения обменной константы и анизотропии не могут существенно повлиять на критическую плотность ВБЛ. Однако, как следует из [4], ВБЛ теряют устойчивость раньше, чем  $4\pi M_s$ , обращается в нуль, поэтому наблюдаемая температура, при которой  $\eta$  становится равной нулю, ниже точки Нееля.

Что касается абсолютных значений предельной плотности  $\eta$  ВБЛ и ее функциональной зависимости от  $4\pi M_s$ , материала, то элементарный расчет по формуле [5]

$$\eta = (\sqrt{2\pi}\Lambda_0)^{-1} = M_s/\sqrt{\pi A} \quad (2)$$

свидетельствует о сильном различии между теорией и экспериментом. На рис. 2 для образцов 4–8 (см. таблицу) представлена графическая зависимость экспериментальных значений  $\eta$  от  $4\pi M_s$ , (кривая 1) и соответствующая кривая (кривая 2), полученная с использованием формулы (2).

Во-первых, обращает на себя внимание то, что для исследованных образцов экспериментальные значения  $\eta$  значительно выше теоретических (для  $4\pi M_s > 200$  Гс — в 5 и более раз). Во-вторых, отличается сам ход зависимости  $\eta = \eta(4\pi M_s)$ . Если теоретическая кривая дает  $\eta = 0$  при  $4\pi M_s$ , то экстраполяция экспериментальной кривой однозначно показывает, что критическая плотность ВБЛ обращается в нуль при ненулевом (около 80 Гс) значении намагниченности насыщения пленки.

Последнее обстоятельство прекрасно коррелирует с температурным экспериментом, обсужденным выше, и позволяет сделать предположение о том, что существует некоторое минимальное значение намагниченности насыщения пленки, ниже которого ВБЛ не могут устойчиво существовать в доменных границах.

Природа всех этих явлений пока неясна, однако следует обратить внимание на то, что при расчете  $\Lambda_0$  [5] использована идеализированная структура ДГ с ВБЛ, характерная скорее лишь для центра ДГ. В ней не учитывается, например, скрученнсоть доменной границы.

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы.

1. Основным параметром феррит-гранатовой пленки, влияющим на критическую плотность ВБЛ в ДГ, является намагниченность насыщения.

2. Для больших значений  $4\pi M_s (> 200$  Гс) экспериментальные величины  $\eta$  превышают теоретические в 5 и более раз.

3. Существует некоторое минимальное значение  $4\pi M_s$ , ниже которого ВБЛ не могут устойчиво существовать в доменных границах.

## Список литературы

- [1] Konishi S. // IEEE Trans. Magn. 1983. Vol. 19. N 5. P. 1838–1847.
- [2] Pougnet P., Arnaud L., Poirier M. et al. // IEEE Trans. Magn. 1991. Vol. 27. N 6. P. 5492–5497.
- [3] Haisma J., Van Mierloo K.L.L., Druyvesteyn W.F., Enz U. // Appl. Phys. Lett. 1975. Vol. 27. N 8. P. 459–462.
- [4] Барыжтар Ф.Г., Линник А.И., Прудников А.М., Ходосов Е.Ф. // ФТТ. 1985. Т. 27. Вып. 8. С. 2503–2504.
- [5] Малоzemов А., Слонзуски Дж. Доменные стенки в материалах с ЦМД. М.: Мир, 1982. 382 с.

05;07;12

© 1994 г.

Журнал технической физики, т. 64, в. 12, 1994

## ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФОТОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В AgJ

B.A. Волл

Санкт-Петербургский государственный университет,  
198904, Санкт-Петербург, Россия  
(Поступило в Редакцию 23 февраля 1993 г.)

Настоящая работа посвящена сравнительной оценке расчетных значений энергий электронных состояний для наиболее вероятных моделей фотолитических центров ( $\Phi\text{Ц}$ ) в AgJ применительно к энергетическим положениям максимумов наведенных полос в оптических спектрах этого вещества.

Модели фотолитических Ag центров в AgJ, привязываемые к известным спектральным данным, рассматривались в [1]. Предпосылками построения моделей были высокая концентрация подвижного  $\text{Ag}^+$  и его участие в образовании  $\Phi\text{Ц}$ , что считается общепризнанным [2], а также локальная модификация структуры решетки до ОЦК или частично разупорядоченной ГЦК, что показано прямыми экспериментами на макрокристаллах [3–5] и по модификации экситонных спектров микрокристаллов AgJ [6,7]. Характерные для AgJ наведенные полосы с максимумами 2.75–2.81, 2.43 и 2.27–2.31 эВ связывались соответственно с  $V_k^- h^+$ ,  $\text{Ag}_2^+$  и  $\text{Ag}_3^+$ , ассоциированными с  $V_k^- h^+$ -центрами [1]. Наведенная полоса с максимумом 3.435 эВ в [8,9] была приписана центрам  $\text{AG}_6^{++}$  как элементарным  $\Phi\text{Ц}$  с  $n$ -типов электропроводности. В частности, сравнение энергии связи  $E_t$  молекул  $\text{Ag}_2$  и  $\text{Ag}_3$  [10] с энергетическим положением максимумов наведенных полос, приписываемых  $\Phi\text{Ц}$  с соответствующим числом атомов Ag, показало хорошее совпадение для  $\Phi\text{Ц}$ , включающего  $\text{Ag}_3^+$  (2.28 и 2.29 эВ соответственно), при условии расположения атомов Ag в вершинах равнобедренного треугольника и  $1.5 \times$  разницу в бинарном варианте центра, которая близка к  $1.4 \times$  росту  $E_t$  в  $\text{Ag}_2^+$  по отношению в  $\text{Ag}_2$  [10]. По предполагаемой модели  $\Phi\text{Ц}$  разница в 0.16 эВ между энергетическим положением максимума спектральной